# 技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业信息** | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | | 扬州虹扬科技发展有限公司 | | | 机构代码 | |  | |
| 区 域 | | | 邗江 | 联系人 | 吴海霞 | | 电话 | | 15995137911 |
| 行业领域 | | | 能源动力 | | | 产业领域 | | 能源动力 | |
| 经济规模 | | | 无 | | | 人员规模 | | 无 | |
| 需求信息 | | | | | | | | | |
| 需求名称 | | | 消除GPP芯片电泳后表面玻璃点 | | | | | | |
| 技术需求情况说明 | 技术需  求类别 | | ☑技术研发（关键、核心技术）  □产品研发（产品升级、新产品研发）  □技术改造（设备、研发生产条件）  □技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | | | |
| 技术  需求  简述 | | 消除GPP芯片电泳后表面玻璃点 | | | | | | |
|  | 技术  需求  详述 | | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）  1、芯片氧化层致密度的提升，既能在芯片电泳时起到有效屏蔽的作用，且在后续湿法去氧化层时又能较快速的去除，减少湿法对沟槽玻璃的损伤。  2、提升光刻胶对芯片表面覆盖的均匀性，增强胶膜的抗腐蚀性，使得芯片在沟槽腐蚀时表面的氧化层得到有效保护，避免钻蚀现象。  3、提高芯片表面平整度，减少芯片表面凹坑。 | | | | | | |
| 现有  基础  情况 | | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）  我司目前自制GPP芯片，玻璃钝化方式采用的是电泳法，芯片沟槽内经电泳后会附着玻璃粉，而芯片表面利用SiO2的屏蔽作用，避免玻璃粉附着。在芯片批量生产中，个别片的部分区域表面，在电泳后出现表面附着玻璃粉，形成点状，经玻璃烧结后，变成坚固的玻璃点附于芯片表面，对芯片外观以及组装焊接造成负面影响 | | | | | | |
| 产学研合作要求 | 简要  描述 | | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）  与哈尔滨理工大学、西安电子科技大学合作 | | | | | | |
| 合作  方式 | | □技术转让 □技术入股 ☑联合开发 □委托研发  □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融  □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购  □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 | | | | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | ☑是 □否  □部分公开(说明） | | | | | | | |
| 同意接受  专家服务 | | ☑是  □否 | | | | | | | |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 | | ☑是  □否 | | | | | | | |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 | | □是，金额万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  □否  法人代表： 年 月 日 | | | | | | | |